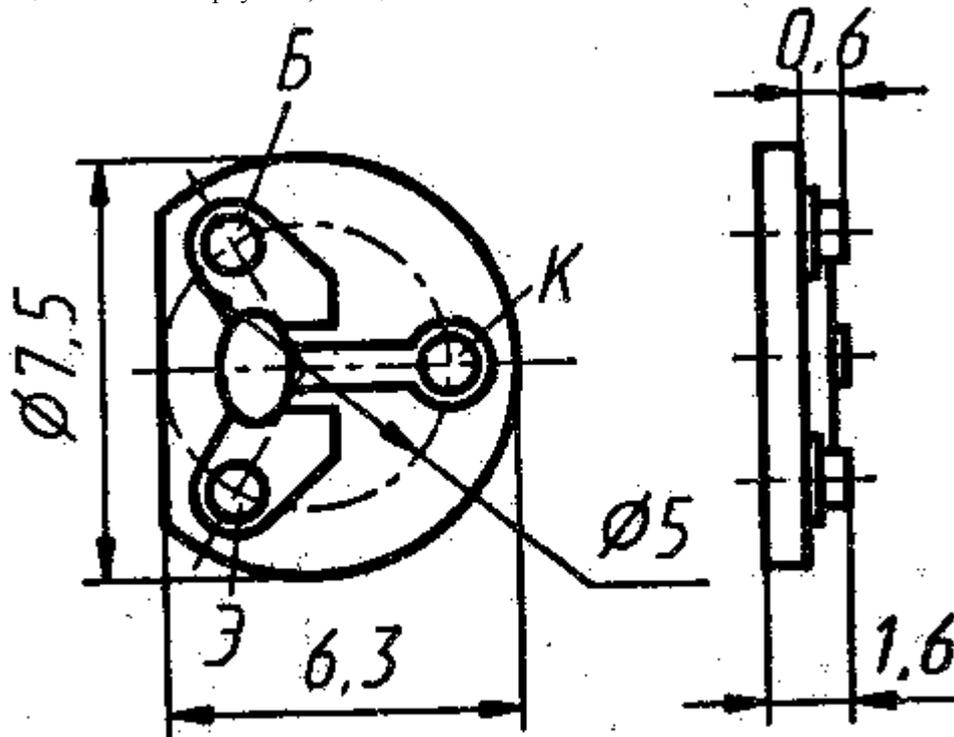


# 1Т614А

Германиевый планарный германиевый n-p-n транзистор. Предназначен для генерирования СВЧ колебаний в схеме с общей базой. Бескорпусной, с защитным покрытием.



## Номинальные электрические данные

Выходная мощность в схеме с общей базой при $U_{кб} = 9 \text{ В}$ , $f = 500 \text{ МГц}$	не менее 200 мВт
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером	15...250
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $f = 100 \text{ МГц}$	не менее 10
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $f = 30 \text{ МГц}$	не более 15 пс
Обратный ток коллектора	не более 10 мкА
Обратный ток эмиттера	не более 5 мкА

## Предельно допустимые электрические величины

Постоянный ток коллектора	200 мА
Постоянное напряжение коллектор – база	12 В
Постоянное напряжение коллектор – эмиттер при $R_{эб} = 0$	9 В
Постоянное напряжение эмиттер – база	0,5 В
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = -60...+50^\circ\text{C}$	400 мВт
при $T = +70^\circ\text{C}$	200 мВт
Температура окружающей среды	$-60 \dots +70^\circ\text{C}$

При монтаже транзистора температура припоя должна быть не выше  $+230^\circ\text{C}$ . Время пайки не должно превышать 3 с.